第一章 态密度

1.1 态密度关系的推导

在间距为 Δk 的两个能态之间存在的态的个数为 $2\Delta k/\delta k$ 其中 $\delta k=2\pi/a/N$,即为第一布里渊区的相邻态间距。那么单位能量间隔的态为 $\delta k=2\pi/a/N/\Delta E$

而能量满足

$$E - E_0 = \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}$$

那么有

$$\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}E}\sqrt{\frac{m^*}{2\hbar^2(E-E_0)}}$$

对于含有 N 个原子的一维链来说 L=Na ,联立,那么单位能量单位长度的态密度为

$$DOS = \frac{1}{\pi} \frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}E} \sqrt{\frac{m^*}{2\hbar^2 (E - E_0)}}$$

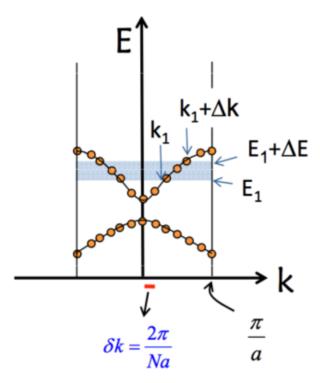


图 1.1: 一维态密度

类似的对于三维体系,在E处的能量间隔中态的数目为

$$\frac{\Delta V}{\delta V} = \frac{4\pi/3[(k+\mathrm{d}k)^3 - k^3]}{(2\pi/L)(2\pi/W)(2\pi/H)} = \frac{V}{2\pi^2k^2\mathrm{d}k}$$

同一维情况的 E-k 关系带入

$$DOS = \frac{m^*}{2\pi^2\hbar^3} \sqrt{2m * (E - E_0)}$$

1.2 常见材料的导带价带

关键在于求得等效质量 m*

$$g_i(E) = \frac{m^*}{2\pi^2\hbar^3} \sqrt{2m*(E-E_0)}, i = c \text{ or } v$$

其中有效质量为

$$\frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\mathrm{d}^2 E}{\mathrm{d}k^2}$$

由于不同材料的能带形状不一样,如椭球型,需要求得其等效质量 m^*_{eff} 。 GaAs 的导带为球形,各个方向的有效质量一致。

Si 与 Ge 的导带形状为椭球形,满足:

$$E - E_C = \frac{\hbar^2 k_1^2}{2m_l^*} + \frac{\hbar^2 k_2^2}{2m_t^*} + \frac{\hbar^2 k_1^2}{2m_t^*}$$

其中 m_t^* 是椭球的长轴等效质量, m_t^* 是短轴的。可以归一化为关于 k_i 的椭球面方程,

$$1 = \frac{k_1^2}{\alpha^2} + \frac{k_2^2}{\beta^2} + \frac{k_3^2}{\beta^2}$$

将第一布里渊区的有效椭球面个数记为 N_{el} , 进而定义有效半径

$$N_{el} \frac{4}{3} \pi \alpha \beta^2 = \frac{4}{3} \pi k_{eff}^3$$

化简得到有效质量

$$m_{eff}^* = N_{el}^{2/3} (m_l^* m_t^{*2})^{1/3}$$

对于 Ge $N_{el}=4$, Si $N_{el}=6$ 。

对于价带,同样由不同的有效质量如重空穴与轻空穴分别对应 $m_{hh}^* m_{lh}^*$ 。

1.3 费米-狄拉克分布

费米能级为 E_F

$$f_0(E) = \frac{1}{1 + e^{\beta(E - E_F)}}$$

其中 $\beta = 1/(k_B T)$

1.4 载流子分布

电子的单位体积个数 (浓度) 可以考虑成导带电子态密度以及电子占据情况下分布函数的加权

$$n = \int_{E_c}^{E_{top}} g_c(E) f(E) dE$$

空穴的单位体积个数 (浓度) 可以考虑成价带空穴态密度以及电子**不**占据情况下分布函数的加权

$$p = \int_{E_hottom}^{E_v} g_v(E)(1 - f(E))dE$$

1.5 玻尔兹曼分布

在导带或者价带能量与费米能级相差 $3k_BT$ 及以上时,费米-狄拉克分布可以弱化为玻尔兹曼分布,并且可以称为简并半导体。

$$n = N_C e^{-\beta (E_c - E_F)}$$

$$p = N_V e^{\beta(E_v - E_F)}$$

其中, N_C 、 N_V 分别是导带价带的有效态密度。

$$N_{C} = 2 \left(\frac{2\pi m_{n}^{*} k_{B} T}{h^{2}} \right)^{3/2}$$

$$N_{V} = 2 \left(\frac{2\pi m_{p}^{*} k_{B} T}{h^{2}} \right)^{3/2}$$

1.6 本征费米能级

由上一节知

$$np = N_C N_V e^{-\beta (E_c - E_v)} = N_C N_V e^{-\beta (E_g)}$$

当 $n = p = n_i$ 时,定义 $E_F = E_i$ 可以解出本征载流子浓度与费米能级

$$n_i = \sqrt{N_C N_V} e^{-E_0/2k_B T}$$

$$E_i = \frac{E_G}{2} + \frac{1}{2\beta} \ln \frac{N_V}{N_C}$$

并且存在关系

$$n_i = N_C e^{(E_i - E_c)/kT}$$

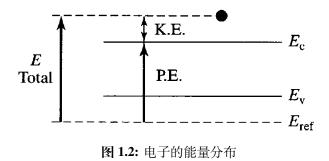
$$n_i = N_V e^{(E_v - E_i)/kT}$$

$$n = n_i e^{(E_F - E_i)/kT}$$

$$p = n_i e^{(E_i - E_F)/kT}$$

1.7 能带图与能量

以一个电子的能量分布为例,空穴类似。



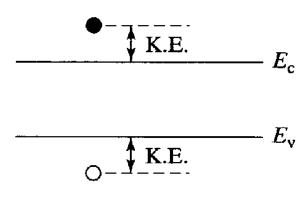


图 1.3: 电子与空穴的对比

可以得到势能满足

$$P.E = E_c - E_{ref} = -qV(x)$$

那么

$$V = -\frac{1}{q}(E_c - E_{ref})$$

电场满足

$$\mathscr{E} = -\nabla V = \frac{1}{q} \frac{\mathrm{d}E_c}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{q} \frac{\mathrm{d}E_v}{\mathrm{d}x}$$